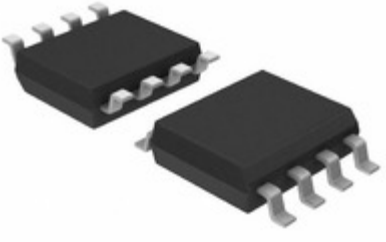


	<h2 style="color: red;">SI4966DY-T1-GE3</h2>
 	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4966DY-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  SI4966DY-T1-GE3.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4966DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7.1A, 4.5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 2W Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Basisteilenummer	SI4966

SI4966DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4966DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4966DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4966DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4966DY-T1-E3.</b> VISHAY SI4966DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4967DY</b> VISHAY SI4967DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-E3 SOP8</b> VISHAY SI4966DY-T1-E3 SOP8 VISHAY</p>
 <p><b>SI4967DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4967DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4966DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4966DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4966DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4966DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4966DY-T1-GE3
SI4966DY-T1-GE3 Electronic	SI4966DY-T1-GE3-Komponenten	SI4966DY-T1-GE3-Verteiler	SI4966DY-T1-GE3-Bild	SI4966DY-T1-GE3-Teil
SI4966DY-T1-GE3 Preis	SI4966DY-T1-GE3 Hersteller	SI4966DY-T1-GE3 Bild	SI4966DY-T1-GE3 Aktie	SI4966DY-T1-GE3 Inventar
SI4966DY-T1-GE3 Neu	SI4966DY-T1-GE3 Original	SI4966DY-T1-GE3 garantiert	SI4966DY-T1-GE3 RFQ	SI4966DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited